

**关键指标**

频率：10~13GHz  
 功率增益：19dB  
 输出功率：33dBm  
 典型附加效率：28%  
 电压/静态电流：VD：8V/800mA，VG：-0.8V  
 外形尺寸：2mm×3mm

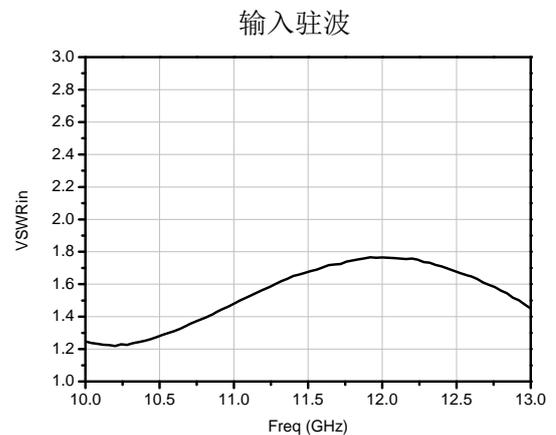
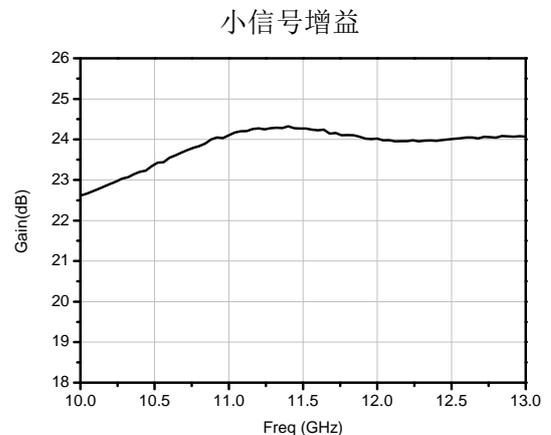
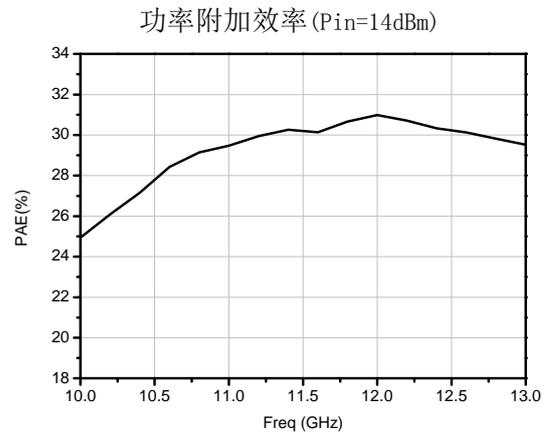
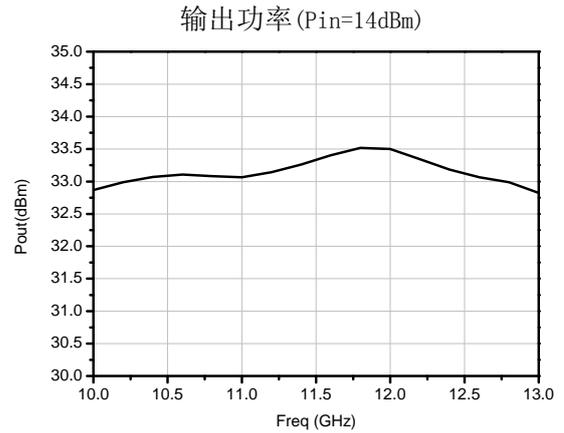
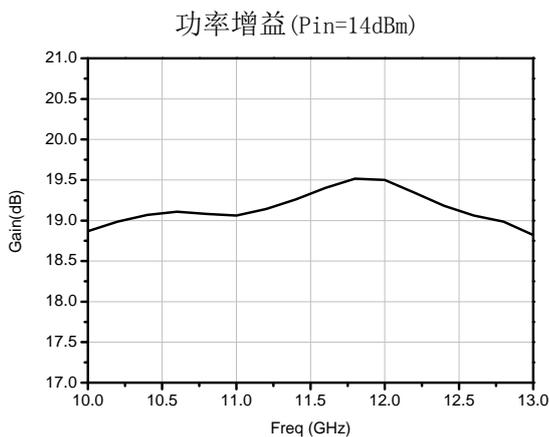
**产品简介**

HG136F6 型芯片是一款 10-13GHz 功率放大器芯片。采用 GaAs pHEMT 工艺制作，该芯片采用双电源供电，漏极电压+8V，静态电流 800mA，全频段饱和输出功率大于 33dBm。射频输入输出端均已集成隔直电容，该芯片主要应用于收发组件、无线通信等领域。

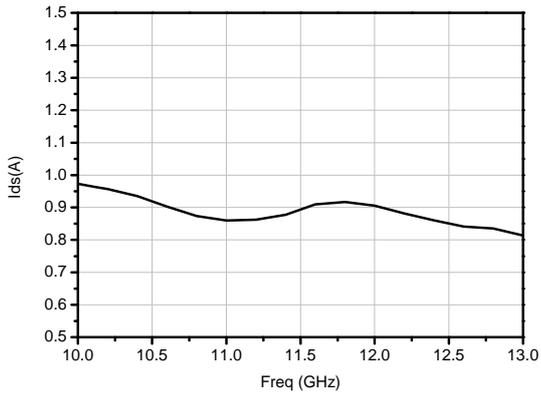
**电性能 (T<sub>A</sub>=25°C, VD=8V, VG=-0.8V)**

指标	最小值	典型值	最大值
频率 (GHz)	10~13		
功率增益 (dB)	-	19	-
增益平坦度 (dB)	-	±0.5	-
小信号增益 (dB)	-	24	-
输入驻波	-	1.6	-
输出功率 (dBm)	-	33	-
输出功率附加效率 (%)	-	28	-
静态电流 (A)	-	0.8	-

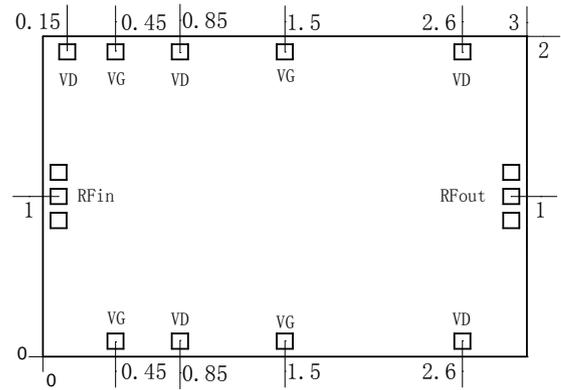
**典型测试曲线**



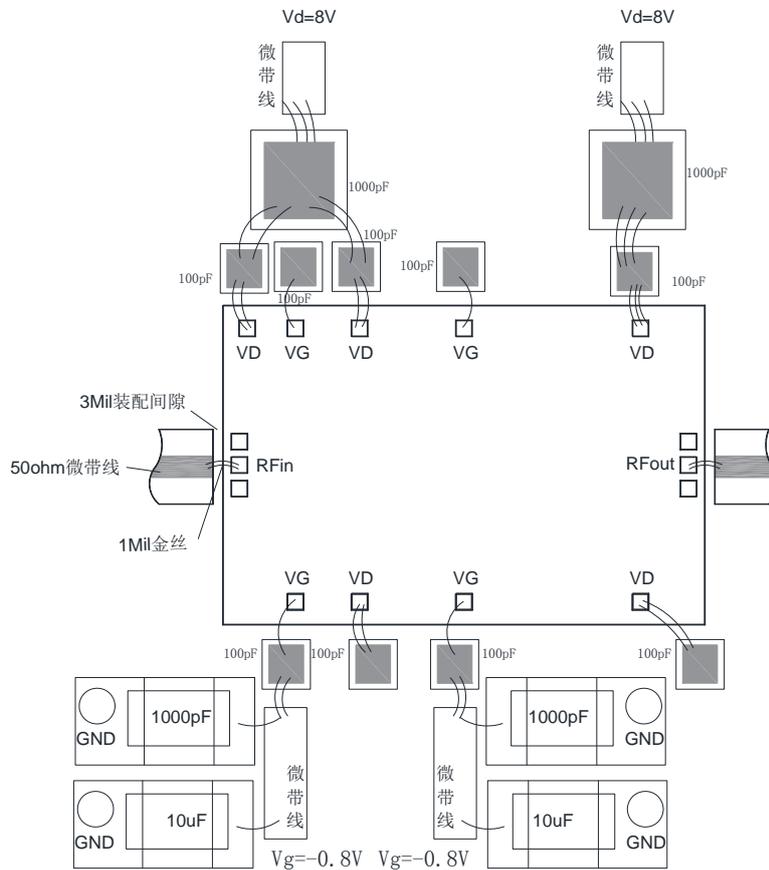
工作电流 (Pin=14dBm)



外形和端口尺寸 (mm)



推荐装配图



\*注: 100pF 电容均为芯片电容

绝对额定最大值

工作电压 VD	+10V
最大输入功率	+20dBm
工作温度	-55°C ~ 125°C
存储温度	-65°C ~ 150°C

注意事项

1. 芯片在干燥、氮气环境中存储，在超净环境使用；
2. GaAs 材料较脆，不能触碰芯片表面，使用时必须小心；
3. 芯片采用金锡烧结，使之充分接地；
4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm，输出端使用  $\Phi 25 \mu\text{m}$  3 根金丝键合，建议金丝长度 250~400  $\mu\text{m}$ ；
5. 芯片微波端有隔直电容；
6. 芯片对静电敏感，在储存和使用过程中注意防静电。